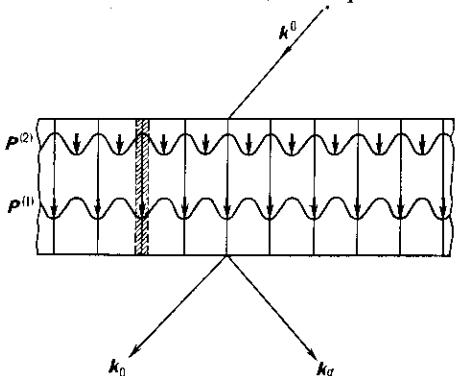


толщиной $d \gg 1/\mu_0$ может проходить только излучение с $D_s^{(2)}$. Пропущенное излучение имеет преимущественную *s*-поляризацию, так как для *p*-поляризации $\chi_i^g \cos 2\theta / \chi_i^{(0)} < 1$ и А. п. э. выражен слабее. А. п. э. существует во всей угловой области дифракционного отражения, однако при увеличении отстройки $\Delta\theta$ от точного угла Брэгга θ он быстро ослабляется.

Пойнтинга векторы полей $D_{s,p}^{(1,2)}$ в соответствии с (1) равны:

$$|\mathbf{P}_{s,p}^{(1,2)}| \sim \begin{cases} \cos^2(gx/2) \\ \sin^2(gx/2) \end{cases} e - \mu_{s,p}^{(1,2)} z \cos \theta \quad (2)$$

и направлены вдоль атомных плоскостей, а их амплитуды в направлении, перпендикулярном атомным плоскостям, модулированы с периодом, равным между плоскостями расстоянию. Вследствие этого $P^{(1)}$ принимает максимум на атомных плоскостях, а $P^{(2)}$ — между ними (рис.). Т. к. осн. вклад в фотоэлектрич. поглощение дают впн. *K*- и *L*-оболочки, электронная плотность



Картина распределения вектора Пойнтинга для полей $D^{(1)}$ и $D^{(2)}$ в совершенном кристалле, атомные плоскости которого перпендикулярны поверхности, при точном выполнении условий Брэгга — Вульфа. k^0 — волновой вектор падающей плоской волны. Потоки энергии направлены вдоль атомных плоскостей и модулированы в направлении оси x так, что для поля $D^{(1)}$ максимумы интенсивности приходятся на атомные плоскости (и поэтому они сильно поглощаются его атомами), а для поля $D^{(2)}$ — между ними (коэффициент поглощения аномально мал). Поскольку потоки энергии направлены вдоль атомных плоскостей, то разделение поля на пропущенную и дифракционную волны происходит при выходе его из кристалла. Пунктиром показано влияние несовершенства структуры кристалла и тепловых колебаний, которые ведут к эффективному увеличению толщины (заштрихованные области) атомной плоскости и, следовательно, сглаживанию эффекта аномального прохождения.

К-рых сосредоточена вблизи атомных ядер, поле $D^{(1)}$ распространяется в области повышенной электронной плотности, взаимодействует со средой и поглощается более интенсивно, а поле $D^{(2)}$ распространяется в области пониженной электропропускной способности и взаимодействует со средой менее интенсивно, чем в произвольном, не дифракционном направлении. Этим и обусловлены аномально низкое поглощение в дифракц. направлении и появление резких максимумов на рентгенограмме.

Тепловые колебания атомов в кристалле эффективно увеличивают размеры атомов, так что $\mu_{s,p}^{(2)}$ возрастает. Напр., при темп-ре $T \approx 300K$

$$\mu_{s,p}^{(2)} = \mu_0 \left(1 - \frac{\chi_i^{(g)}}{\chi_i^0} e^M \right) \simeq 4 \cdot 10^{-2} \mu_0,$$

где e^M — Дебая—Валлера фактор. А. п. э. зависит также от структуры кристалла. Любые отклонения от идеальных условий (атомные плоскости не перпендикулярны кристаллографич. плоскостям, наличие отстройки от точного угла θ , дефектов) уменьшают А. п. э. При многолучевой дифракции могут существовать области, где А. п. э. проявляется сильнее.

А. п. э. используется для исследования совершенства строения кристаллов (см. Рентгеновская топография) и получения слаборасходящихся пучков монохроматич. поляризов. рентг. излучения. А. п. э. имеет место и для др. излучений.

Лит. см. при ст. Дифракция рентгеновских лучей.

А. В. Колпаков.

АНОМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ плаズмы — сопротивление, связанное с развитием разл. токовых неустойчивостей и возникающее, когда плотность тока в плазме превышает нек-ую критич. величину. А. с. плазмы связано только с гибридными электрон-ионными неустойчивостями и по величине существенно превышает обычное классич. сопротивление за счёт парных электрон-ионных соударений. Критич. плотность тока j , при к-рой возникает А. с., обычно выражают через пороговое значение дрейфовой скорости электронов $v_d = j/ne$ (e — заряд электрона, n — их плотность). Наличие дрейфовой скорости у электронов означает, что электронное распределение по скоростям сдвинуто на величину v_d относительно ионного, что и приводит к неустойчивости. Вследствие этой неустойчивости электроны, кроме потери импульса при парных столкновениях, теряют его и при излучении колебаний (волн). Эти колебания поглощаются ионами и передают им свой импульс. Т. о., так же как и при парных столкновениях, происходит передача импульса от электронов к ионам, однако в данном случае она имеет коллективную природу, т. к. осуществляется посредством возбуждаемых при неустойчивости колебаний и волн. Иногда значение дрейфовой скорости, при к-рой возникают неустойчивость и А. с., чрезвычайно мало. Напр., в плазме без магн. поля миним. значение скорости v_d , при к-рой возникает ионно-звуковая неустойчивость (см. Неустойчивости плазмы), существенно меньше тепловой скорости электронов и фактически совпадает со скоростью ионного звука в плазме $v_s = \sqrt{T_e/M}$ (T_e — темп-ра электронов, M — масса ионов). Ионно-звуковая неустойчивость представляет собой раскачуку продольных эл.-статич. колебаний в плазме с «горячими» электронами и «холодными» ионами ($T_e \gg T_i$). При приближении v_d к тепловой скорости электронов ионно-звуковая неустойчивость плавно переходит в неустойчивость Бунемана.

В плазме, помешённой в магн. поле, возможны токовые неустойчивости с очень низким порогом v_d , значительно меньшим тепловой скорости ионов. Эти неустойчивости возникают, когда ток течёт попрёк магн. поля (неустойчивость Драммонда—Розенблюта, неустойчивость нижнегибридных колебаний).

Осн. проблемой в теории А. с. является установление связи между линейной теорией токовых неустойчивостей и их разл. нелинейными характеристиками. Наиб. употребительной линейной характеристикой токовых неустойчивостей является эф. частота $\omega_{\text{эфф}}$ рассеяния электронов колебаниями при нелинейном насыщении роста неустойчивости. Для ионно-звуковой неустойчивости, к-рая играет центральную роль в теории А. с., $\omega_{\text{эфф}} = 10^{-2} \omega_p v_d T_e / v_T T_i$, где $\omega_p = \sqrt{4\pi ne^2/m}$ — плазменная электронная частота, v_T — тепловая скорость электронов, m — масса электронов. Величина аномальной проводимости связана с $\omega_{\text{эфф}}$ обычной ф-лой электропроводности плазмы $\sigma_a = ne^2/mv_{\text{эфф}}$.

Осн. трудности в теории А. с. связаны с тем, что вследствие квазилинейной деформации функций распределения электронов и ионов величины v_d , T_e , T_i уже не имеют своего обычного смысла. При исследовании деформации ионного распределения весьма эффективным оказывается использование т. н. двухтемпературного приближения, т. е. разбиения ионов на две группы — «холодные» ионы, не меняющие своего распределения по скоростям, и «хвост» ионной ф-ции распределения, ускоряемый за счёт взаимодействия с колебаниями. Характерные скорости таких ионов $v_{\text{эфф}}$